

Silicon NPN Transistor

S673T

350V / 50mA

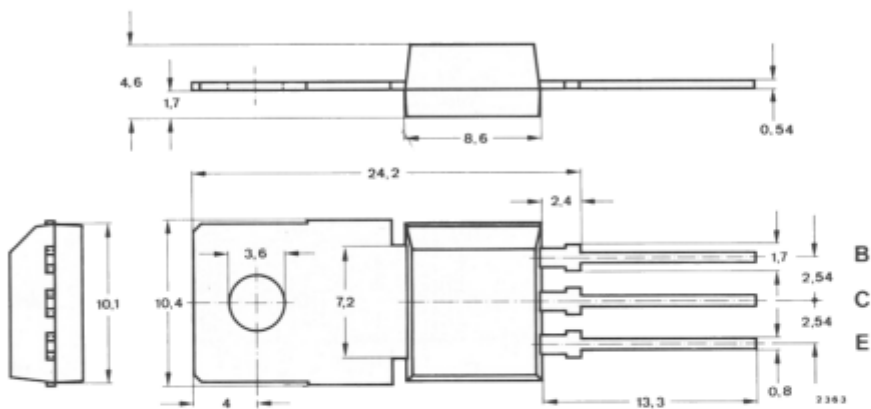
DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985

S 673 T**Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren****Anwendungen:** Video-B-Endstufen in Fernsehempfängern**Besondere Merkmale:**

- Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

Normgehäuse
34 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 202
Gewicht max. 1.8 g

Kollektor mit metallischer Montagefläche verbunden

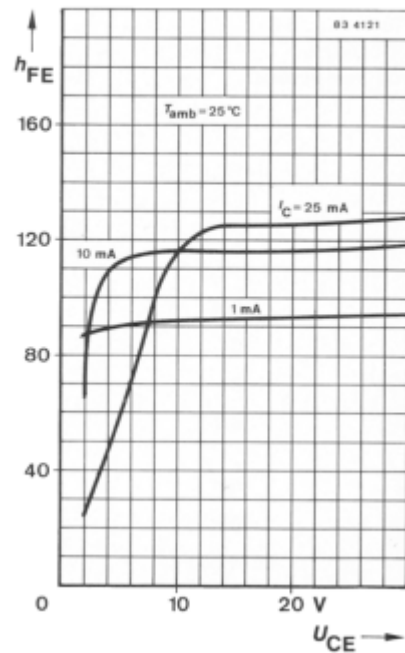
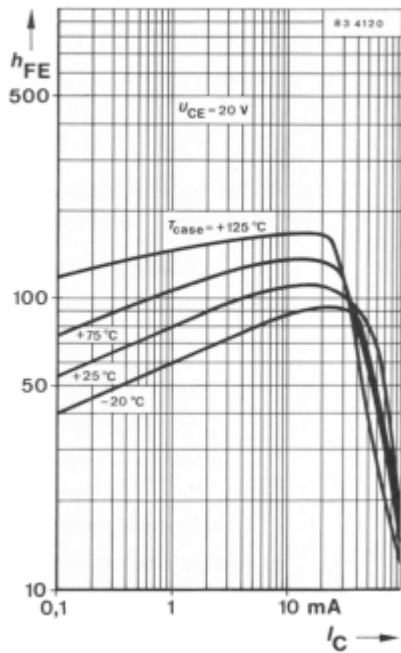
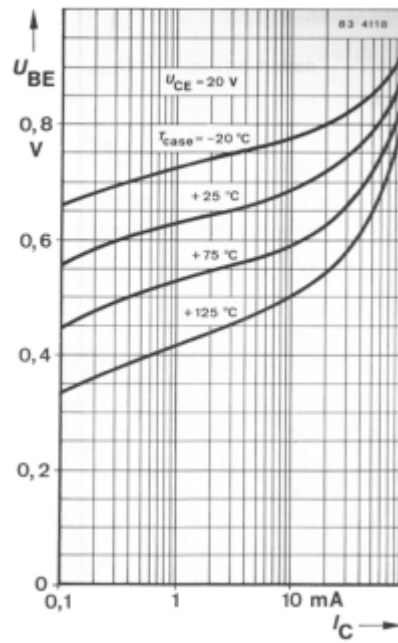
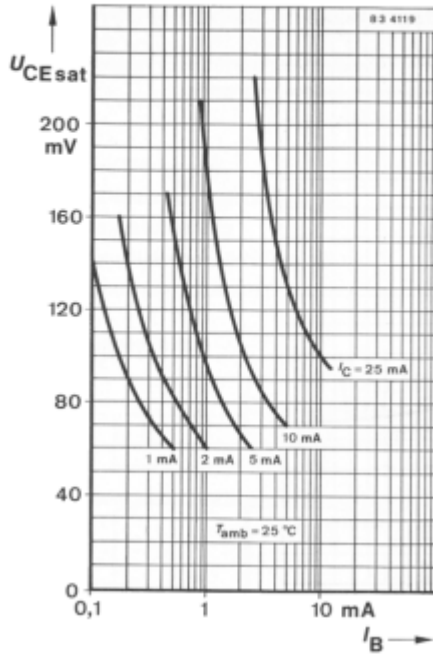
Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung	U_{CBO}	350	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung $R_{BE} \leq 2.7 \text{ k}\Omega$	U_{CER}	300	V
Emitter-Basis-Sperrspannung	U_{EBO}	5	V
Kollektorstrom	I_C	50	mA
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	100	mA
Gesamtverlustleistung $T_{case} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	7	W
Sperrschichttemperatur	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-65...+150	$^\circ\text{C}$

S 673 T

Wärmewiderstände		Min.	Typ.	Max.	
Sperrschicht-Umgebung	R_{thJA}			78	K/W
Sperrschicht-Gehäuse	R_{thJC}			17.8	K/W
Kenngroßen					
$T_{amb} = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Kollektorreststrom					
$U_{CE} = 250\text{ V}$, $R_{BE} = 2.7\text{ k}\Omega$,	I_{CER}			50	nA
$U_{CE} = 200\text{ V}$, $R_{BE} = 2.7\text{ k}\Omega$, $T_j = 150\text{ °C}$	I_{CER}			10	μA
Emitterreststrom					
$U_{EB} = 5\text{ V}$	I_{EBO}			10	μA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung					
$I_C = 1\text{ }\mu\text{A}$, $R_{BE} = 2.7\text{ k}\Omega$	$U_{(BR)CER}$	300			V
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis					
$U_{CE} = 20\text{ V}$, $I_C = 25\text{ mA}$	h_{FE}	50			
Transitfrequenz					
$U_{CB} = 10\text{ V}$, $I_C = 10\text{ mA}$	f_T	60			MHz
Rückwirkungskapazität					
$U_{CB} = 30\text{ V}$, $I_C = 0\text{ mA}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{ure}			1.8	pF
Kollektor-HF-Sättigungsspannung					
$I_C = 25\text{ mA}$, $T_j = 150\text{ °C}$	$U_{CEsat HF}$		20		V

S 673 T



S 673 T